

17-2T-1405

2SD1068は、ガードリング，SIPOS膜等の技術を用いて作られた高電圧増幅，スイッチング用のTr.で複写機，ファクシミリ等の制御回路。ドライブ回路に最適です。

1. 特長
- ・高耐圧  $V_{CBO} 1kV$
  - ・小電流の  $h_{FE}$  が高い。  $h_{FE} \geq 30$  at  $I_C = 100\mu A$
  - ・2SB832とコンプリメンタリ動作ができる
2. 構造 Si NPN SIPOS Tr.
3. 用途 電圧増幅
4. 外形 TO-220

5. 絶対最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	1000V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	900V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	10V
コレクタ電流(パルス)	$I_{CP}$	1A
コレクタ電流	$I_C$	10mA
ベース電流	$I_B$	5mA
コレクタ損失	$P_C(T_a = 25^\circ C)$	1.1W
"	$P_C(T_c = 25^\circ C)$	25W
接合部温度	$T_j$	120 $^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-50~+150 $^\circ C$

6. 電気的特性 (Ta=25 °C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	$I_C=0.1\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=2\text{mA}$	900			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=0.1\text{mA}$	10			V
コレクタ遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE}=1000\text{V}, R_{EB}=0$			10	$\mu\text{A}$
"	$I_{CHER}$	$V_{CE}=900\text{V}, R_{EB}=50\text{k}\Omega$			50	$\mu\text{A}$
エミッタ遮断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=10\text{V}, I_C=0$			2	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	50			
"	$h_{FE2}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=0.1\text{mA}$	30			
コレクタ接合容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$		4.5	6	$\text{pF}$
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=1\text{mA}$	5	8.5		MHz
スイッチング時間	$t_d$	Fig.1.		3.2		$\mu\text{s}$
	$t_r$	$V_{CC}=500\text{V}$		14.0		$\mu\text{s}$
	$t_{stg}$	$I_C=1\text{mA}$		32.0		$\mu\text{s}$
	$t_r$			14.0		$\mu\text{s}$

7. マーク表示

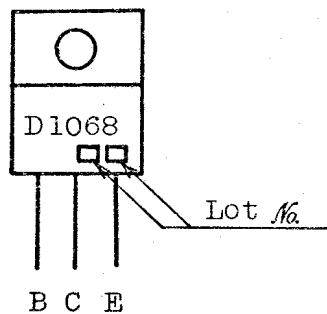
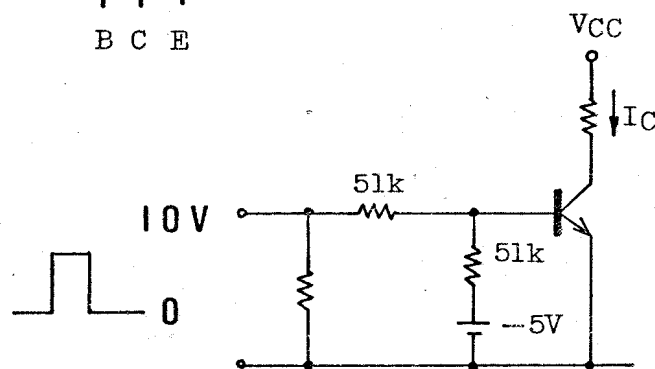
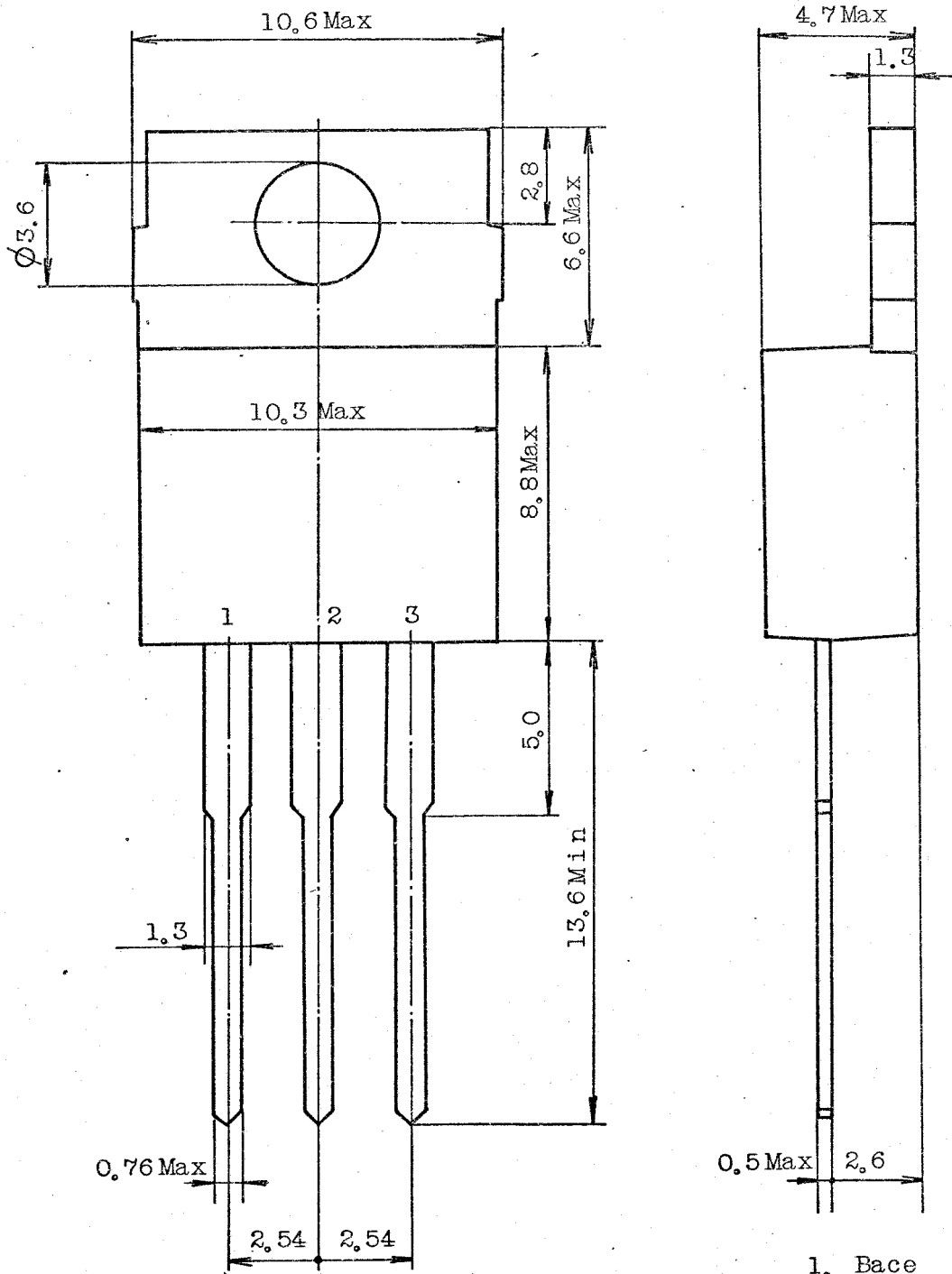


Fig.1



外形図



- 1. Base
- 2. Collector
- 3. Emitter

Unit: mm